

12A、600V N沟道增强型场效应管

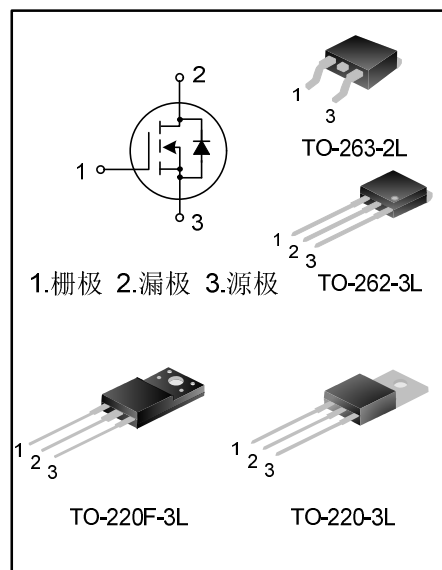
描述

SVF12N60T/F/S/K N沟道增强型高压功率 MOS 场效应晶体管采用士兰微电子 F-Cell™ 平面高压 VDMOS 工艺技术制造。先进的工艺及原胞结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。

该产品可广泛应用于 AC-DC 开关电源，DC-DC 电源转换器，高压 H 桥 PWM 马达驱动。

特点

- ◆ 12A, 600V, $R_{DS(on)}$ (典型值) = $0.58\Omega @ V_{GS}=10V$
- ◆ 低栅极电荷量
- ◆ 低反向传输电容
- ◆ 开关速度快
- ◆ 提升了 dv/dt 能力



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装
SVF12N60T	TO-220-3L	SVF12N60T	无铅	料管
SVF12N60F	TO-220F-3L	SVF12N60F	无铅	料管
SVF12N60S	TO-263-2L	SVF12N60S	无卤	料管
SVF12N60STR	TO-263-2L	SVF12N60S	无卤	编带
SVF12N60K	TO-262-3L	SVF12N60K	无铅	料管

极限参数(除非特殊说明, $T_c=25^{\circ}\text{C}$)

参 数	符 号	参数范围				单 位
		SVF12N60T	SVF12N60F	SVF12N60S	SVF12N60K	
漏源电压	V_{DS}	600				V
栅源电压	V_{GS}	± 30				V
漏极电流	I_D	$T_c=25^{\circ}\text{C}$				A
		12				
		$T_c=100^{\circ}\text{C}$				
		7.6				
漏极脉冲电流	I_{DM}	48				A
耗散功率 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$) - 大于 25°C 每摄氏度减少	P_D	225	51	180	213	W
		1.8	0.41	1.44	1.7	$\text{W}/^{\circ}\text{C}$
单脉冲雪崩能量 (注 1)	E_{AS}	798				mJ
工作结温范围	T_J	$-55\sim+150$				$^{\circ}\text{C}$
贮存温度范围	T_{stg}	$-55\sim+150$				$^{\circ}\text{C}$

热阻特性

参 数	符 号	参数范围				单 位
		SVF12N60T	SVF12N60F	SVF12N60S	SVF12N60K	
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	0.56	2.44	0.69	0.59	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.5	62.5	62.5	62.5	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

电气参数(除非特殊说明, $T_c=25^{\circ}\text{C}$)

参 数	符 号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单 位
漏源击穿电压	B_{VDSS}	$V_{GS}=0\text{V}, I_D=250\mu\text{A}$	600	--	--	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=600\text{V}, V_{GS}=0\text{V}$	--	--	1.0	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$	--	--	± 100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu\text{A}$	2.0	--	4.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10\text{V}, I_D=6.0\text{A}$	--	0.58	0.75	Ω
输入电容	C_{iss}	$V_{DS}=25\text{V}, V_{GS}=0\text{V},$ $f=1.0\text{MHz}$	--	1367	--	pF
输出电容	C_{oss}		--	152	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	14.0	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=300\text{V}, I_D=12\text{A},$ $V_{GS}=10\text{V}, R_G=24\Omega$ (注 2, 3)	--	24.33	--	ns
开启上升时间	t_r		--	51.93	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	87.93	--	
关断下降时间	t_f		--	47.73	--	
栅极电荷量	Q_g	$V_{DS}=480\text{V}, I_D=12\text{A},$ $V_{GS}=10\text{V}$ (注 2, 3)	--	33.5	--	nC
栅极-源极电荷量	Q_{gs}		--	7.57	--	
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}		--	15.2	--	

源-漏二极管特性参数

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	I_S	MOS 管中源极、漏极构成的反偏	--	--	12	A
源极脉冲电流	I_{SM}	P-N 结	--	--	48	
源-漏二极管压降	V_{SD}	$I_S=12A, V_{GS}=0V$	--	--	1.3	V
反向恢复时间	T_{rr}	$I_S=12A, V_{GS}=0V,$	--	530	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}	$di_F/dt=100A/\mu S$ (注 2)	--	4.8	--	μC

注:

1. $L=30mH, I_{AS}=6.66A, V_{DD}=100V, R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_J=25^\circ C$;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$;
3. 基本上不受工作温度的影响。

典型特性曲线

图 1. 输出特性

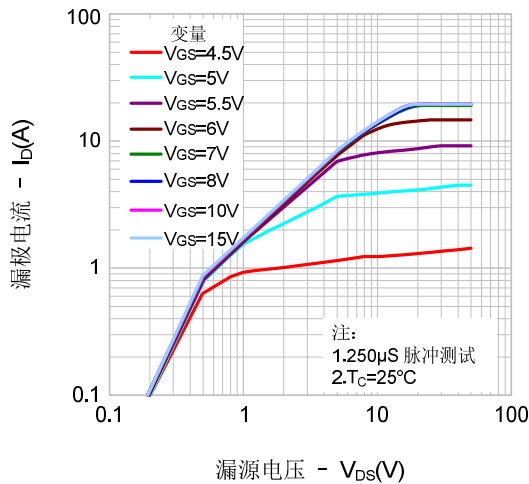


图 2. 传输特性

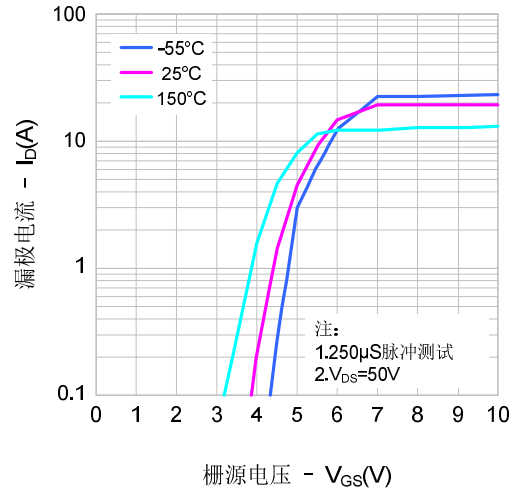


图 3. 导通电阻 vs. 漏极电流

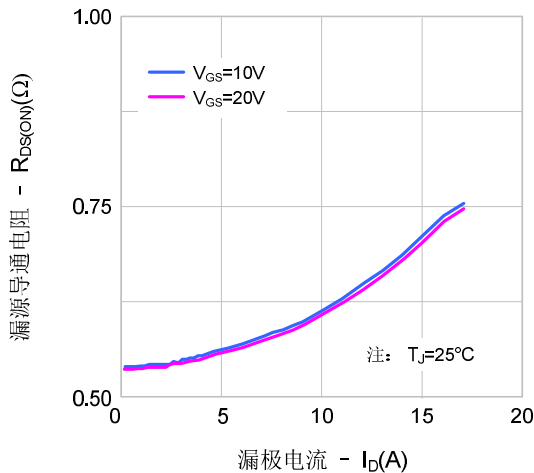
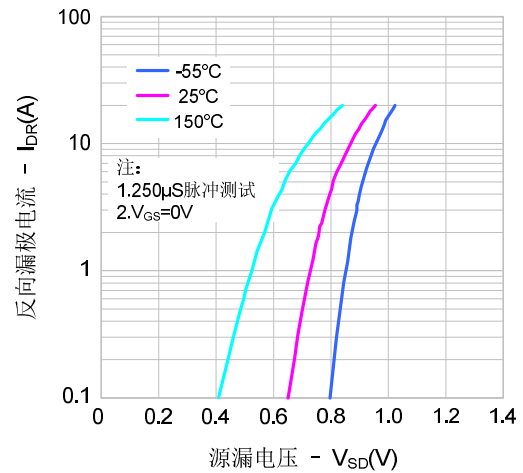


图 4. 体二极管正向压降 vs. 源极电流、温度



典型特性曲线 (续)

图5. 电容特性

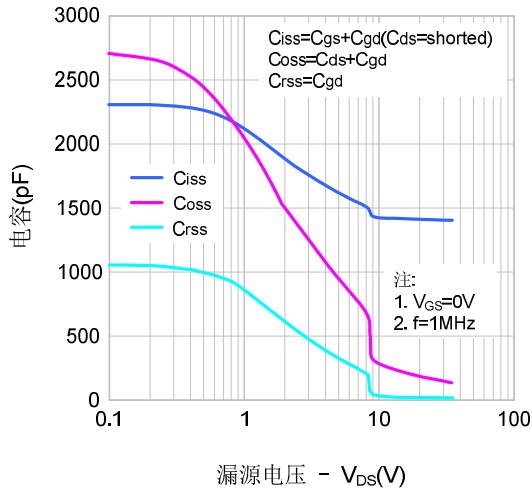


图6. 电荷量特性

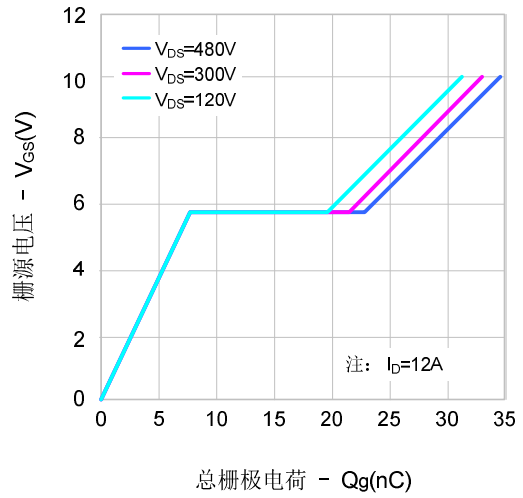


图7. 击穿电压vs.温度特性

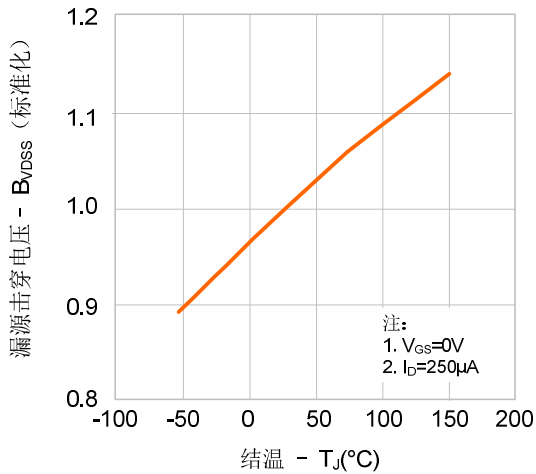


图8. 导通电阻vs.温度特性

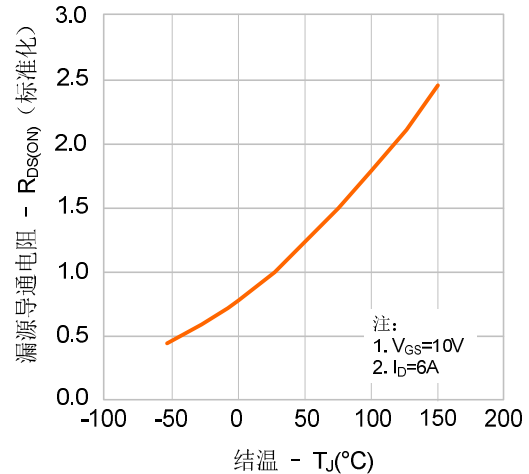


图9-1. 最大安全工作区域(SVF12N60F)

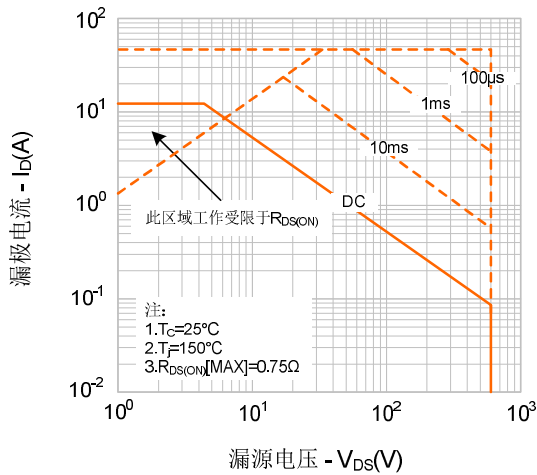
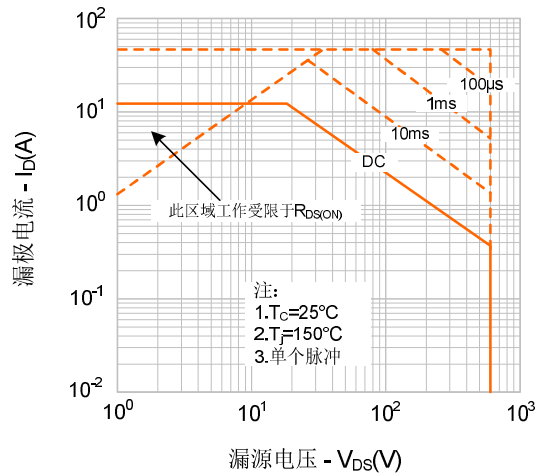


图9-2. 最大安全工作区域(SVF12N60T)



典型特性曲线 (续)

图9-3. 最大安全工作区域(SVF12N60S)

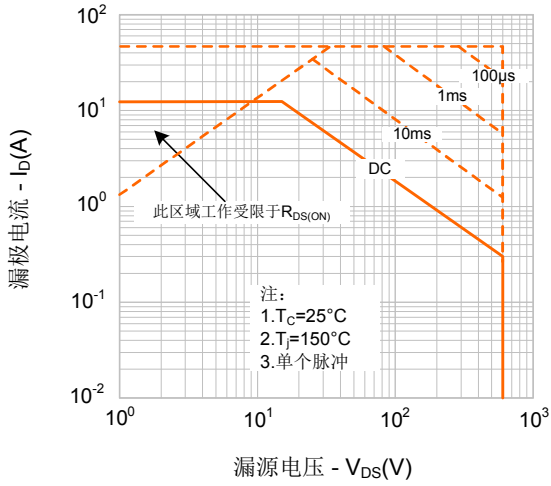


图9-4. 最大安全工作区域(SVF12N60K)

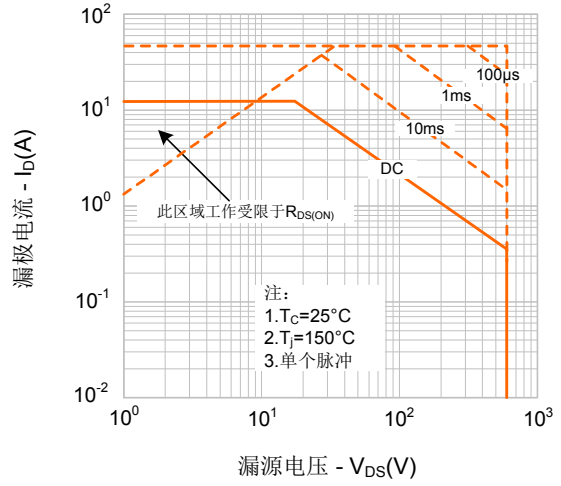
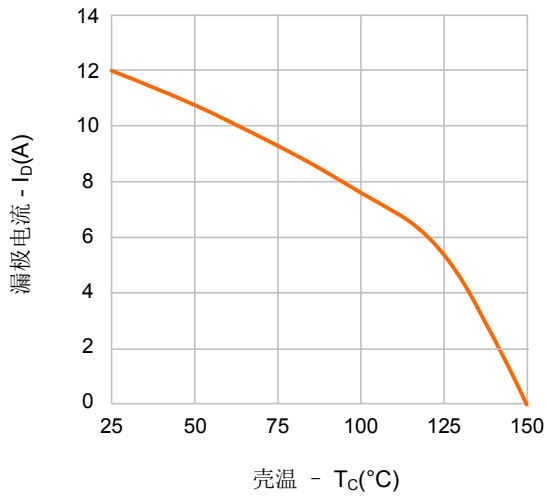
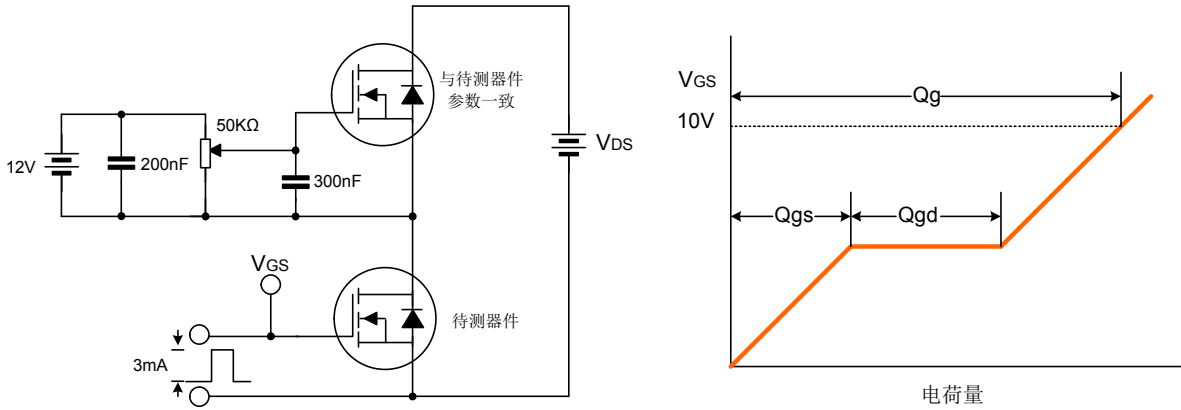


图10. 最大漏极电流vs. 壳温

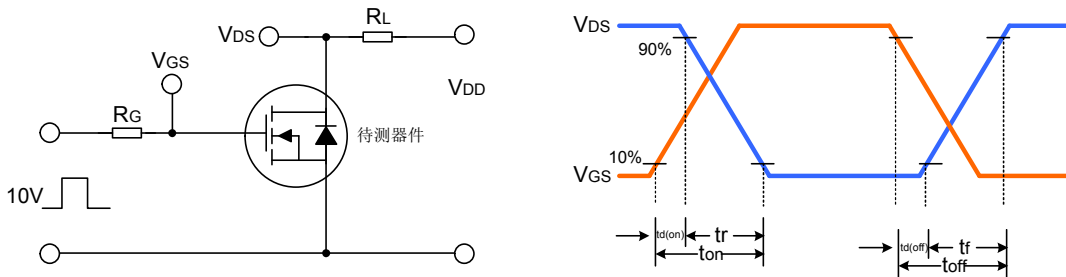


典型测试电路

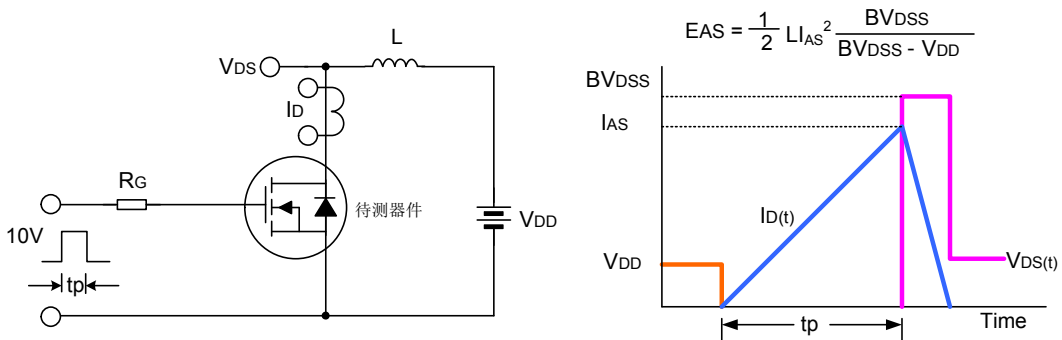
栅极电荷量测试电路及波形图



开关时间测试电路及波形图



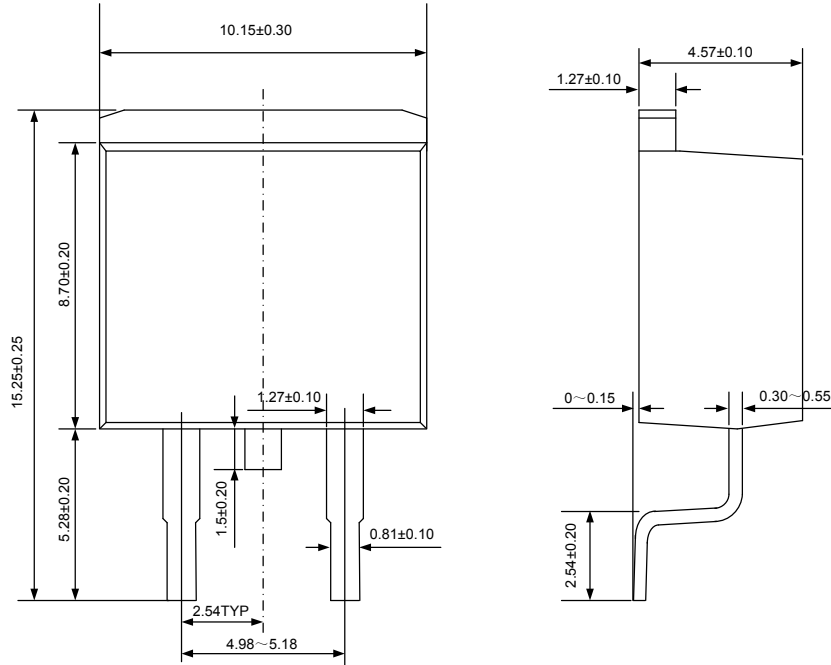
EAS测试电路及波形图



封装外形图

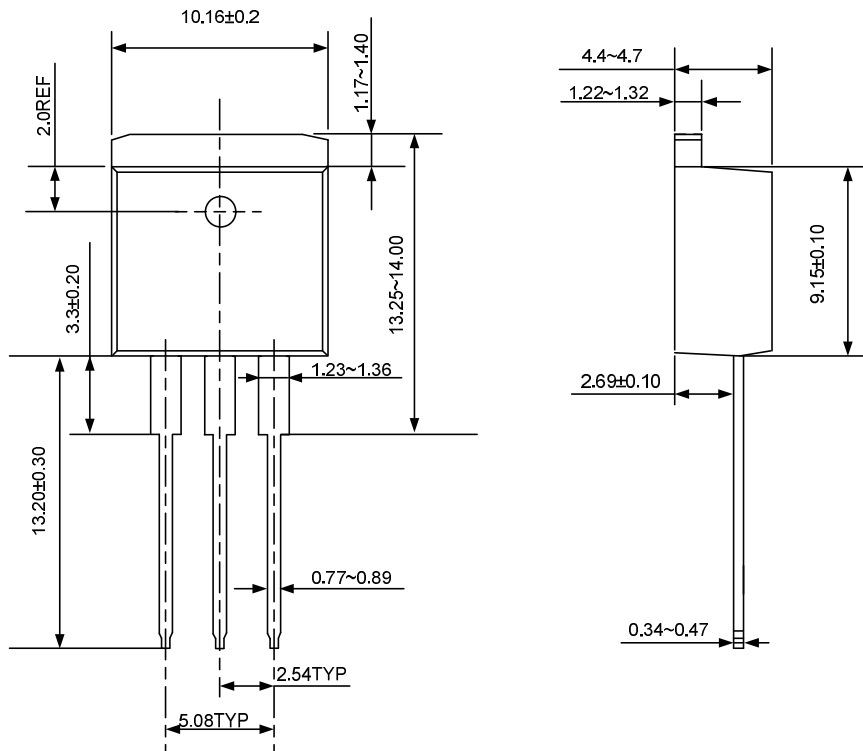
TO-263-2L

单位：毫米



TO-262-3L

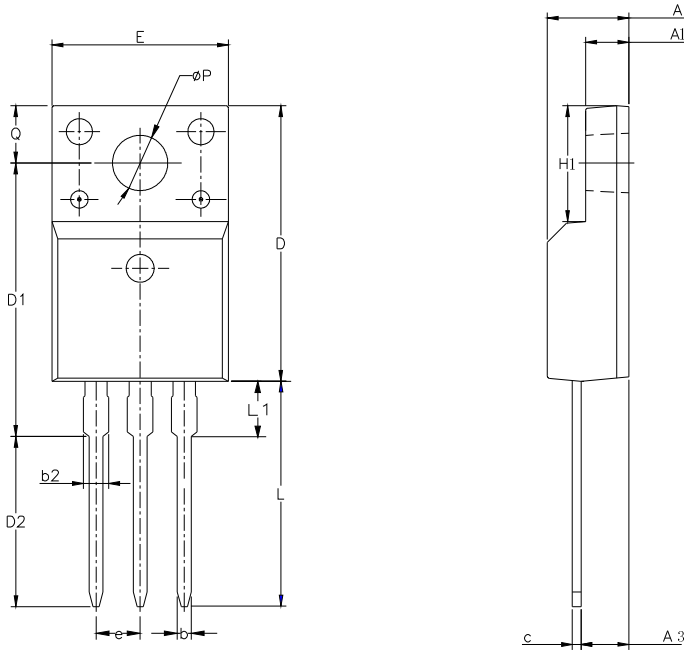
单位：毫米



封装外形图(续)

TO-220F-3L

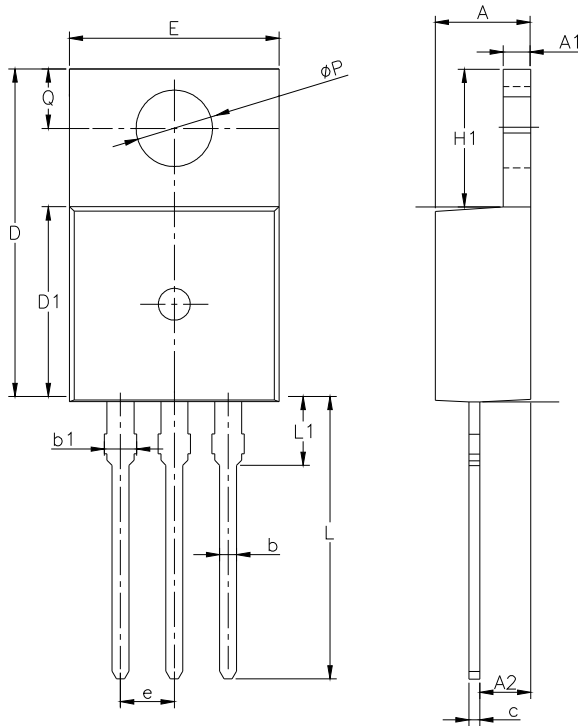
单位: 毫米



SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	4.42	4.70	5.02
A1	2.30	2.54	2.80
A3	2.50	2.76	3.10
b	0.70	0.80	0.90
b2	—	—	1.47
c	0.35	0.50	0.65
D	15.25	15.87	16.25
D1	15.30	15.75	16.30
D2	9.30	9.80	10.30
E	9.73	10.16	10.36
e	2.54BCS		
H1	6.40	6.68	7.00
L	12.48	12.98	13.48
L1	/	/	3.50
ϕP	3.00	3.18	3.40
Q	3.05	3.30	3.55

TO-220-3L

单位: 毫米



SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	4.30	4.50	4.70
A1	1.00	1.30	1.50
A2	1.80	2.40	2.80
b	0.60	0.80	1.00
b1	1.00	—	1.60
c	0.30	—	0.70
D	15.10	15.70	16.10
D1	8.10	9.20	10.00
E	9.60	9.90	10.40
e	2.54BSC		
H1	6.10	6.50	7.00
L	12.60	13.08	13.60
L1	—	—	3.95
ϕP	3.40	3.70	3.90
Q	2.60	—	3.20

声明:

- ◆ 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。
- ◆ 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！
- ◆ 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！

产品名称:	SVF12N60T/F/S/K	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn
版 本:	2.2	作 者:	殷资
修改记录:	1. 修改电气参数		
版 本:	2.1	作 者:	殷资
修改记录:	1. 修改产品规格分类 2. 修改 TO-220-3L 封装信息		
版 本:	2.0	作 者:	殷资
修改记录:	1. 修改封装信息		
版 本:	1.9	作 者:	殷资
修改记录:	1. 修改热阻特性		
版 本:	1.8	作 者:	殷资
修改记录:	1. 修改产品规格分类		
版 本:	1.7	作 者:	林莹
修改记录:	1. 修改 MOS 管符号的示意图		
版 本:	1.6	作 者:	林莹
修改记录:	1. 修改“封装外形图”		
版 本:	1.5	作 者:	林莹
修改记录:	1. 增加 TO-262-3L 封装		
版 本:	1.4	作 者:	林莹
修改记录:	1. 修改 $R_{DS(on)}$ 典型值		
版 本:	1.3	作 者:	林莹
修改记录:	1. 修改 T_{rr} 和 Q_{rr} 的值 2. 修改“电容值”		

3. 修改图 5

版本： 1.2 作者： 林莹

修改记录：

1. 增加 SVF12N60F 无卤信息

版本： 1.1 作者： 林莹

修改记录：

1. 修改“封装外形图”

版本： 1.0 作者： 林莹

修改记录：

1. 原版
-

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [MOSFET](#) category:

Click to view products by [Silan](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[614233C](#) [648584F](#) [MCH3443-TL-E](#) [MCH6422-TL-E](#) [FDPF9N50NZ](#) [FW216A-TL-2W](#) [FW231A-TL-E](#) [APT5010JVR](#) [NTNS3A92PZT5G](#)
[IRF100S201](#) [JANTX2N5237](#) [2SK2464-TL-E](#) [2SK3818-DL-E](#) [FCA20N60_F109](#) [FDZ595PZ](#) [STD6600NT4G](#) [FSS804-TL-E](#) [2SJ277-DL-E](#)
[2SK1691-DL-E](#) [2SK2545\(Q,T\)](#) [D2294UK](#) [405094E](#) [423220D](#) [MCH6646-TL-E](#) [TPCC8103,L1Q\(CM](#) [367-8430-0972-503](#) [VN1206L](#)
[424134F](#) [026935X](#) [051075F](#) [SBVS138LT1G](#) [614234A](#) [715780A](#) [NTNS3166NZT5G](#) [751625C](#) [873612G](#) [IRF7380TRHR](#)
[IPS70R2K0CEAKMA1](#) [RJK60S3DPP-E0#T2](#) [RJK60S5DPK-M0#T0](#) [APT5010JVFR](#) [APT12031JFLL](#) [APT12040JVR](#) [DMN3404LQ-7](#)
[NTE6400](#) [JANTX2N6796U](#) [JANTX2N6784U](#) [JANTXV2N5416U4](#) [SQM110N05-06L-GE3](#) [SIHF35N60E-GE3](#)